

1. P. M. Morse and H. Feshbach. Methods of theoretical physics Mc Graw - Hill, 1953.
2. V. B. Matveev. Darboux invariance and the solutions of Zakharov-Schabat equations, Preprint de Paris - Sud, 79/7, 16/79.
3. Lê Văn Trúc. Mầm của đa hệ địa phương, TCKH ĐHTH Hà Nội, No 2, 18 (1986)

Le Van Truc - ON THE METHOD FOR SOLVING VOLTERRA INTEGRAL EQUATION

In this paper, a class of linear volterra integral operators of convolution type is investigated. The kernel of the operator satisfies a certain linear ordinary differential equation with constant coefficients.

Bộ môn VLLT- ĐHTH Hà Nội

Nhận ngày

VỀ LÝ THUYẾT GIA TĂNG SÓNG ÂM TRONG BÁN DẪN BỞI TRƯỜNG BỨC XẠ LASER

NGUYỄN QUANG BÁU, NGUYỄN VĂN

1. Lý thuyết gia tăng sóng âm trong bán dẫn bởi trường một sóng điện từ (SĐT) laser $E \sin \Omega t$ (E và Ω tương ứng là vectơ cường độ và tần số) đã được nghiên cứu trong công trình [1, 2]. Các tác giả [1, 2] đã chỉ ra rằng: dưới ảnh hưởng của trường một SĐT, toàn năng - xung lượng của hệ điện tử - phonon trong bán dẫn bị biến thể với sự các photon vào quá trình hấp thụ và phát ra các phonon (trong hàm $\delta(x)$ biểu diễn toàn năng - xung lượng, ngoài các số hạng là năng lượng của điện tử và phonon, $\epsilon_\ell \Omega$ là năng lượng của photon ($\ell = 0, \pm 1, \pm 2 \dots$ và trong hệ $\hbar = 1$). Đây là một nguyên nhân chính làm thay đổi nhiều tính chất. Trong đó có tính chất hấp thụ sóng âm: hệ số hấp thụ sóng âm thay đổi về độ lớn và về dấu, trở nên âm ($\gamma_T < 0$) trong vectơ sóng âm \vec{q} (tức chuyển từ hấp thụ sang gia tăng sóng âm).

Trong bài này chúng tôi đưa ra một số kết quả nghiên cứu góp phần phát triển lý thuyết gia tăng sóng âm trong bán dẫn không suy biến bởi trường hai SĐT $E_1 \sin \Omega_1 t$, có kể đến ảnh hưởng của quá trình hấp thụ nhiều photon (điều mà tác giả [3] cố gắng giải quyết nhưng không thành công). Như sẽ chỉ ra ở phần dưới, sự có SĐT một lần nữa làm cho định luật bảo toàn năng - xung lượng biến thể (thay bây giờ là $\epsilon_1 \Omega_1 + \epsilon_2 \Omega_2$) và điều này lại kéo theo hệ số gia tăng và vùng vectơ sóng âm điều kiện gia tăng sóng âm thay đổi so với khi chỉ có mặt một SĐT.

2. Xuất phát từ Hamiltonian của hệ điện tử - phonon trong bán dẫn có kể đến vào ngay từ đầu, phát triển phương pháp [4], thiết lập phương trình động lượng thu nhận phương trình tán sắc, rồi với giả thiết: tương tác điện tử - phonon là yếu. nghĩa với phonon âm, từ phương trình tán sắc chúng tôi tính hệ số gia tăng và điều kiện gia tăng sóng âm trong hai trường hợp:

a) Hấp thụ một photon: $\lambda_{1,2} \equiv (\epsilon \vec{F}_{1,2} \vec{q} / m \Omega_{1,2}) < \Omega_{1,2}$ (trong đó ϵ và m là điện tích và khối lượng của điện tử). Trong vùng vectơ sóng âm ứng với điều kiện gia tăng:

$$\omega_q / \Omega_{1,2} < 1; \quad \omega_q / (\Omega_1 \pm \Omega_2) < 1$$

hệ số gia tăng sóng âm $\gamma_T < 0$ và có dạng:

$$\begin{aligned} \gamma_T = & -\frac{n_0}{q} \left(\frac{2\pi m}{k_0 T} \right)^{\frac{1}{2}} |C_{q1}|^2 \left\{ J_1^2 \left(\frac{\lambda_1}{\Omega_1} \right) J_0^2 \left(\frac{\lambda_2}{\Omega_2} \right) F(\Omega_1) + J_0^2 \left(\frac{\lambda_1}{\Omega_1} \right) \cdot J_1^2 \left(\frac{\lambda_2}{\Omega_2} \right) F(\Omega_2) + \right. \\ & \left. + J_1^2 \left(\frac{\lambda_1}{\Omega_1} \right) J_1^2 \left(\frac{\lambda_2}{\Omega_2} \right) [F(\Omega_1 + \Omega_2) + F(\Omega_1 - \Omega_2)] \right\}, \quad (2) \\ &) = s h \left(\frac{x}{2k_0 T} \right) s h \left(\frac{m\omega_T x}{q^2 k_0 T} \right) \exp \left[-\frac{m}{2q^2 k_0 T} (\omega_T^2 + x^2 + \frac{q^4}{4m^2}) \right] \end{aligned}$$

là hàm Bessel đối số thực, C_{q1} là hằng số tương tác điện tử - phonon âm, T là nhiệt độ Boltzman, n_0 là nồng độ điện tử ω_T - tần số phonon âm.

thụ nhiều photon: $\lambda_1 < \Omega_1$, $\lambda_2 > \Omega_2$ và $\omega_T \gg \frac{q^2}{2m}$. Trong vùng vectơ sóng âm ứng n gia tăng:

$$\pi\omega_T/2\lambda_2 < 1; \quad \pi(\omega_T \pm \Omega_2)/2\lambda_2 < 1 \quad (3)$$

hệ số gia tăng sóng âm $\gamma_T < 0$ và có dạng:

$$\begin{aligned} \gamma_T = & -\frac{n_0}{q} \left(\frac{\pi m}{2k_0^3 T^3} \right)^{\frac{1}{2}} |C_{q1}|^2 \left\{ J_2^2 \left(\frac{\lambda_1}{\Omega_1} \right) \phi(\omega_T) + J_1^2 \left(\frac{\lambda_1}{\Omega_1} \right) \cdot [\phi(\omega_T + \Omega_1) + \phi(\omega_T - \Omega_1)] \right\}, \quad (4) \\ & \left(\frac{2\lambda_2}{\pi} - x \right) \exp \left[-m(x - \lambda_2)^2 / 2q^2 k_0 T \right]. \end{aligned}$$

thu nhận (3) và (4) chúng tôi tránh sai lầm của tác giả công trình [3] bằng cách sử dụng công thức đúng cho tổng [5]:

$$J_2^2(\lambda_2/\Omega_2) \delta(\epsilon - \Omega_2) \approx \frac{1}{\pi} \Theta(\lambda_2^2 - \epsilon^2) [\lambda_2^2 - \epsilon^2]^{-\frac{1}{2}}, \quad (\text{trong đó } \Theta(x) \text{ là hàm bậc thang}).$$

Trong phần cuối của bài báo, chúng tôi lưu ý là các công thức (1) - (4) lần đầu thu được trong hai SDT. Qua đánh giá so sánh với trường hợp chỉ có một SDT, độ lớn của hệ số (2), (4) lớn hơn (5% + 10%), điều kiện gia tăng (1), (3) thay đổi khác và dẫn tới việc tính SDT cho phép gia tăng sóng âm ứng với một số vùng vectơ sóng mà ở đó dùng một công thức gia tăng được.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Эпштейн. Письма в ЖЭТФ, 13, 511 (1971).
 Шмелёв, И. А. Чайковский, Э. М. Эпштейн, Нгуен Куанг Бай. ФТП, 13, 1881 (1979).
 S. Lima et al J Phys. C : Solid Stat. Phys., 12, 145 (1979)
 Шмелёв, Нгуен Куанг Бай. Сб. Физ. Явления в полупроводниках. Кишинёв 1987, 12.
 ГИМАР. Туннельный эффект в сверхпроводниках и его применение. М. 1974.

Nguyen Van Huong - ON THE THEORY OF AMPLIFICATION OF SOUND IN SEMICONDUCTORS BY FIELD OF LASER RADIATION

Amplification of sound in non-degenerate semiconductors by two electromagnetic waves is considered. The coefficient of amplification of sound and the conditions of amplification of sound are calculated and discussed.

in VLLT- ĐHTH Hà Nội

Nhận ngày 20.3.1990